

[Title of the Invention] substrate delivery apparatus and coating/developing system

[Abstract]

[Object]

Provided is a substrate delivery apparatus and a coating/developing system which can accurately manage a time period for which an exposed substrate is heat-processed and can form a uniform line width.

[Solving means]

10

15

20

5

In an interface section 5, a conveyer 110 is disposed so as to face a second cooling device group 80 in a processing station 3. A heating device group 112 composed of heating devices 111 in multiple stages is disposed on one side of the conveyer 110, while on the other side of the conveyer 110, a peripheral exposure device 113, buffer cassette 114, and a wafer holding section 115 are disposed in this order from the above, so as to sandwich the conveyer 110. Between the wafer holding section 115 and an exposure device 4, a second conveying body 116 is disposed. Through the second conveying body 116, conveyance of a wafer W is performed between an in-stage 401 and an out-stage 402 in the exposure device 4.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-077014

(43) Date of publication of application: 23.03.2001

(51)Int.Cl.

H01L 21/027 G03F 7/38 H01L 21/68 // G03F 7/30

(21)Application number : 2000-182000

(71)Applicant: TOKYO ELECTRON LTD

(22) Date of filing:

16.06.2000

(72)Inventor: UEDA KAZUNARI

(30)Priority

Priority number: 11186674

Priority date : 30.06.1999

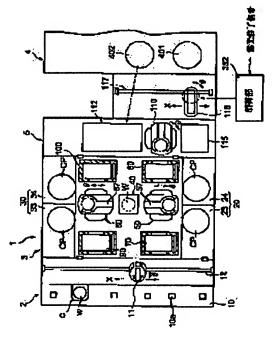
Priority country: JP

(54) SUBSTRATE TRANSFER DEVICE AND SUSTEM FOR COATING- DEVELOPMENT **PROCESS**

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To precisely control time until an exposed substrate is heat-treated and to form an uniform line width.

SOLUTION: In an interface part 5, a transfer device 110 is arranged so that it faces a second cooling processor group 80 in a processing station 3, a heat processor group 112 where heat treatment devices are arranged in multiple stages is arranged in one side so that the transfer device 110 is interposed therebetween, and peripheral exposure equipment, a buffer cassette and a wafer-holding part 115 are successively arranged in lamination on the other side from the top. A secondary transfer body 116 is arranged between the wafer holding part 115 and an



exposure device 4, and a wafer W is carried in/out between an in-stage 401 and an outstage 402 in the exposure device 4 through the body 116.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

25.11.2004

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3914690

[Date of registration]

09.02.2007

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-77014 (P2001-77014A)

(43)公開日 平成13年3月23日(2001.3.23)

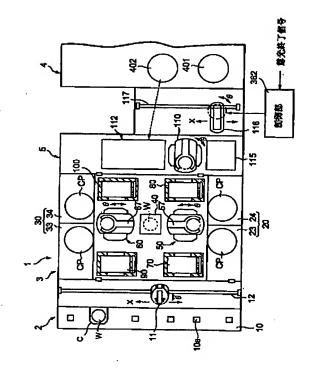
徽 別記号	F1 H01L 21/	30 562	テーマコード(参考)
511	H01L 21/	30 562	
E 1 1			
5 1 1	G03F 7/	38 5 1 1	
	H01L 21/	68	A
5 0 1	G03F 7/	30 5 0 1	
	H01L 21/	30 5 0 2	J
審查請求	未請求 請求項の	D数14 OL (全 10	頁) 最終頁に続く
平成12年 6 月 16日 (2000. 6. 16)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	東京エレクトロン株式 東京都港区赤坂5丁目 上田 一成	3番6号
	i		
日本(JP)	(74)代理人 1	100104215	
	審査請求 等顧2000-182000(P2000-182000) P成12年6月16日(2000.6.16) 等顧平11-186674 P成11年6月30日(1999.6.30)	501 G03F 7/ H01L 21/ 審査請求 未請求 請求項の 寺願2000-182000(P2000-182000) (71)出願人 (P成12年6月16日(2000.6.16) (72)発明者 寺願平11-186674 P成11年6月30日(1999.6.30) (74)代理人 1	501 G03F 7/30 501 H01L 21/30 502 審査請求 未請求 請求項の数14 OL (全 10 等顧2000-182000(P2000-182000) (71)出願人 000219967 東京エレクトロン株式 東京都港区赤坂5丁目 (72)発明者 上田 一成 熊本県菊池郡菊陽町津 平成11年6月30日(1999.6.30) 成本県菊池郡菊陽町津

(54) 【発明の名称】 基板受け渡し装置及び塗布現像処理システム

(57)【要約】

【課題】 露光後の基板を加熱処理するまでの時間を正確に管理するととができ、均一な線幅を形成するととが可能な基板受け渡し装置及び塗布現像理システムの提供。

【解決手段】 インターフェイス部5では、搬送装置 1 1 0 が処理ステーション 3 における第 2 冷却処理装置群 8 0 と対面するように配置され、この搬送装置 1 1 1 0 を挟むように、その一方には熱処理装置 1 1 1 を多段に配置してなる熱処理装置群 1 1 2 が配置され、他方には周辺露光装置 1 1 3、バッファカセット 1 1 4 及びウェハ保持部 1 1 5 が上から順番に積層配置されている。ウェハ保持部 1 1 5 と露光装置 4 との間には 2 次搬送体 1 1 6 が配置され、これを介して露光装置 4 におけるインステージ 4 0 1 及びアウトステージ 4 0 2 との間でウェハ Wの搬入出を行うようになっている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板に対してレジストを塗布し露光後の 基板を現像する塗布現像処理装置と前記レジストが塗布 された基板を露光する露光装置との間に配置され、これ らの装置との間で基板を受け渡す基板受け渡し装置にお

1

前記基板を加熱する加熱部を有する熱処理部と、

前記窓光装置から鍛入された基板を直接的に前記熱処理 部に搬送し、前記塗布現像処理装置側から搬入された基 板を前記露光装置に搬送する第1の搬送部とを具備する 10 いることを特徴とする基板受け渡し转置。 ことを特徴とする基板受け渡し装置。

【請求項2】 請求項1に記載の基板受け渡し装置にお

前記翼光装置から出力される露光終了信号を入力する手

前記露光終了信号に基づき、基板が前記露光装置により 露光が終了してから前記熱処理部に接送されるまでの時 間が一定となるように、前記第1の搬送部を制御する手 段を更に具備することを特徴とする基板受け渡し装置。

【請求項3】 請求項1又は請求項2に記載の基板受け 20 渡し鉄匠において、

少なくとも前記露光前の基板を受け入れ一旦保持する保 **待部を更に具備することを特徴とする基板受け渡し袋**

【請求項4】 請求項1から請求項3のうちいずれか1 項に記載の基板受け渡し装置において、

前記熱処理部が、前記加熱部で加熱された基板を温調す る温調部を前記加熱部と一体的に有することを特徴とす る基板受け渡し装置。

【請求項5】 請求項3に記載の基板受け渡し装置にお 30

前記盤布現像処理装置と隣接すると共に前記保持部と前 記熱処理部との間に配置され、前記盤布現像処理装置と 前記保持部と前記熱処理部との間で基板を搬送する第2 の搬送部を見に具備することを特徴とする基板受け渡し 接置。

【請求項6】 請求項3記載の基板受け渡し装置におい

前記保持部が、前記選光前の基板を前記紙送部から受け 入れ一旦保持し基板が常温付近の温度となるように温調 する温調台を垂直方向に多段に有することを特徴とする 基板受け渡し装置。

【請求項7】 請求項1から請求項6のうちいずれか1 項に記載の基板受け渡し装置において、

前記熱処理部が垂直方向に多段に配置されていることを 特徴とする基板受け渡し装置。

【請求項8】 請求項3記載の基板受け渡し装置におい

前記露光前の基板を周辺露光する周辺露光部と、前記周 辺露光された茎板を垂直方向に多段に保持するバッファ 50 部へ接送するまでの時間が一定となるように制御する手

部とが前記保持部と垂直方向に1列に配置され、かつこ れら周辺露光部及びバッファ部が前記搬送部との間で基 板の受け渡しが可能とされていることを特徴とする基板 受け渡し装置。

【請求項9】 請求項1から請求項8のうちいずれか1 項に記載の基板受け渡し装置において、

前記窓光装置と前記算1の搬送部との間に、前記露光装 置における露光前の基板が載置されるインステージ及び 露光後の基板が載置されるアウトステージが配置されて

【請求項10】 請求項1から請求項8のうちいずれか 1項に記載の基板受け渡し装置において、

前記第1の鍛送部は、前記盤布現像処理装置、前記熱処 **翅部、前記舊光装置における舊光前の墓板が咸置される** インステージ、露光後の基板が就置されるアウトステー ジにより聞まれて、且つ、これちとの間で基板の受け渡 しが可能であることを特徴とする基板受け渡し装置。

【請求項11】 請求項1)記載の基板受け渡し装置に おいて、

前記第1の鍛送部と隣接し、少なくとも前記露光前の基 板を受け入れ一旦保持する保持部を更に具備し、

前記第1の銀送部は、前記保持部との間で基板の受け渡 しが可能であることを特徴とする基板受け渡し装置。

【請求項】2】 基板に対してレジストを塗布し露光後 の基板を現像する塗布現像処理装置と前記レジストが塗 布された基板を露光する露光装置との間に配置され、こ れらの装置との間で基板を受け渡す基板受け渡し装置に おいて、

前記露光装置側への基板の撥出が可能で、前記露光前の 基板を受け入れ一旦保持する第1の保持部と、

前記第1の保持部と同一の平面上に配置され、前記露光 装置側からの基板の鍛入が可能で、前記露光後の基板を 受け入れ一旦保持する第2の保持部と、

前記基板を加熱する加熱部を有する熱処理部と、

前記堂布現像処理装置と隣接すると共に前記第1の保持 部と前記第2の保持部と前記熱処理部に囲まれるように 配置され、前記盤布現像処理装置と前記第1の保持部と 前記第2の保持部と前記熱処理部との間で基板を搬送す る第1の報送部と.

前記第1の保持部との間で基板の鍛入が可能であり、更 に前記算2の保持部との間で基板の搬出が可能であり、 かつ前記奪光装置における露光前の基板が載置されるイ ンステージと露光後の基板が載置されるアウトステージ との間で基板の扱入出が可能な第2の接送部とを具備す ることを特徴とする基板受け渡し装置。

【請求項13】 請求項12記載の基板受け渡し装置に おいて、

前記器光装置側から鍛入された基板を前記第2の搬送 部、第2の保持部及び第1の撤送部を介して前記熱処理

http://www4.ipdl.inpit.go.jp/tjcontentdben.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N040... 11/19/2007

(3)

待開2001-77014

段を更に具備することを特徴とする基板受け渡し装置。 【請求項 1.4 】 レジストが塗布された基板を露光する 露光装置に接続される塗布現像処理システムにおいて、 前記基板に対してレジストを塗布し露光後の基板を現像 する堡布現像処理装置と.

前記翼光装置と前記塗布現像処理装置との間に配置され た基板受け渡し装置とを備え、

前記基板受け渡し装置が、

前記墓板を加熱する加熱部を有する熱処理部と、

前記電光装置から鍛入された基板を直接的に前記熱処理 10 部に接送し、前記塗布現像処理装置側から鍛入された基 板を前記露光装置に鍛送する鍛送部とを具備することを 特徴とする塗布現像処理システム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば半導体ウェ ハやガラス基板等の基板上にレジストを塗布し、現像す る堂布現像処理装置とレジストが塗布された基板を奪光 する露光装置との間に配置される基板受け渡し装置及び 該基板受け渡し装置を備えた塗布現像処理システムに関 20 する.

[0002]

【従来の技術】半導体デバイスの製造におけるフォトレ ジスト処理工程においては、例えば半導体ウェハ(以 下、「ウェハ」という。)等の基板に対してレジストを 塗布し、所定のバターンを躍光した後に、このウェハに 対して現像液を供給して現像処理している。

【①①①3】従来から、これらの処理は、露光装置に対 してレジスト塗布と現像処理を行う塗布現像処理装置を 接続したシステムによって行われている。かかる堂布現 像処理装置には、ウェハの釜布現像処理に必要な一連の 処理。例えばレジストの定着性を向上させるための疎水 化処理(アドヒージョン処理)、レジストを塗布するレ ジスト塗布処理。レジスト塗布後のウェハを加熱してレ ジストを硬化させる加熱処理、露光後のウェハを所定の 温度で加熱するための加熱処理、露光後のウェハに対し て現像処理を能す現像処理等の各処理を個別に行う処理 ユニットが備えられ、ウェハ鍛送装置によってこれら処 理コニット間でのウェハの受け渡しが行われるようにな っている。そして、かかる塗布現像処理装置と露光装置 40 との間には、ウェハの受け渡しをするためのインターフ ェイス部が配置されており、塗布現像処理装置によりレ ジストが塗布されたウェハはこのインターフェイス部を 介して露光装置に受け渡され、露光装置により露光され たウェハはこのインターフェイス部を介して塗布現像処 理装置に受け渡されるようになっている。

【0004】ところで、ウェハ上に形成される配象パタ ーン等をはらつきがなく均一な根据とするためには、上 記の一連の処理では特にウェハを露光装置によって露光 である。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、露光装 置によって露光されたウェハをインターフェイス部を介 して受け取って加熱処理ユニットまで搬送するウェハ鍛 送装置は上述したように各種の処理ユニット間でのウェ ハの受け渡しを行っていることから、非常に忙しく、そ のため露光後のウェハを直ぐには加熱処理ユニットまで 鍛送することができずに待たせる場合もある、という課 野がある。

【①①①⑥】本発明はかかる課題を解決するためになさ れたもので、露光後の基板を加熱処理するまでの時間を 正確に管理することができ、均一な線帽を形成すること が可能な基板受け渡し装置及び塗布現像処理システムを 提供することを目的としている。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、本発明の第1の観点は、基板に対してレジストを塗 布し露光後の基板を現像する塗布現像処理装置と前記レ ジストが塗布された基板を露光する露光装置との間に配 置され、これらの装置との間で基板を受け渡す基板受け 渡し装置において、前記基板を加熱する加熱部を有する 熱処理部と、前記選光装置から鍛入された基板を直接的 に前記熱処理部に鍛送し、前記塗布現像処理装置側から 搬入された基板を前記葉光装置に搬送する第1の搬送部 とを具備する。

【0008】本発明の第2の観点は、基板に対してレジ ストを塗布し窓光後の基板を現像する塗布現像処理装置 と前記レジストが塗布された基板を露光する露光装置と の間に配置され、これらの装置との間で基板を受け渡す 基板受け渡し装置において、前記露光装置側への基板の 鐵出が可能で、前記露光前の基板を受け入れ一旦保持す る第1の保持部と、前記第1の保持部と同一の平面上に 配置され、前記露光装置側からの基板の鍛入が可能で、 前記羅光後の基板を受け入れ一旦保持する第2の保持部 と、前記基板を加熱する加熱部を有する熱処理部と、前 記盤布現像処理装置と隣接すると共に前記第1の保持部 と前記第2の保持部と前記熱処理部に囲まれるように配 置され、前記盤布現像処理装置と前記第1の保持部と前 記第2の保持部と前記熱処理部との間で基板を接送する 第1の鍛送部と、前記第1の保持部との間で基板の鍛出 が可能であり、更に前記第2の保持部との間で基板の鍛 入が可能であり、かつ前記露光装置における露光前の基 板が載置されるインステージと露光後の基板が載置され るアウトステージとの間で基板の鍛入出が可能な第2の 鍛送部とを具備する。

【0009】本発明の第3の観点は、レジストが塗布さ れた基板を露光する露光装置に接続される塗布現像処理 システムにおいて、前記基板に対してレジストを盤布し した後に加熱処理するまでの時間を管理することが重要 50 露光後の基板を現像する盤布現像処理装置と、前記露光 (4)

装置と前記金布現像処理装置との間に配置された基板受 け渡し装置とを構え、前記基板受け渡し装置が、前記基 板を加熱する加熱部を有する熱処理部と、前記露光装置 から扱入された基板を直接的に前記熱処理部に接送し、 前記盤布現像処理装置側から鍛入された基板を前記露光 装置に鍛送する搬送部とを具備する。

【①①】①】本発明では、露光後の基板を、当該基板受 け渡し装置が有する鍛送部を介して熱処理部へ直接的に 受け渡して加熱処理するように構成したので、露光後の 基板を待たせることなく直ぐに熱処理部へ鍛送して加熱 10 処理を行わせることができる。従って、露光後の基板を 加熱処理するまでの時間を正確に管理することができ、 均一な線幅を形成することができる。

[0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面 に基づき説明する。

【0012】図1~図3は実施の形態にかかる塗布現像 処理システムの外観を示し、図1は平面から、図2、図 3は側面から見た様子を各々示している。

【0013】この塗布現像処理システム1は、例えば2 20 5枚のウェハ♥をカセット単位で外部から塗布現像処理 システム!に対して鍛入出したり、カセットCに対して ウェハΨを鍛入出するためのカセットステーション2 と、塗布現像処理工程の中でウェハWに対して所定の処 理を施す枚葉式の各種処理装置を多段配置してなる処理 ステーション3と、この処理ステーション3に隣接して 設けられる露光装置4との間でウェハWの受け渡しをす るための基板受け渡し装置としてのインターフェイス部 5とを一体に接続した構成を有している。

【()() 14】カセットステーション2では、カセット就 30 置台10上の位置決め突起10aの位置に、複数個のカ セットCがウェハ♥の出入口を処理ステーション3側に 向けてX方向(図1中の上下方向)に沿って一列に献置 自在である。そして、このカセットCの配列方向(X方 向)及びカセットCに収容されたウェハWの配列方向

(乙方向: 金直方向) に移動可能なウェハ鍛送体 11が 搬送路12に沿って移動自在であり、 各力セットCに対 して選択的にアクセスできるようになっている。

【0015】このウェハ搬送体1.1は8方向にも回転自 在に構成されており、後述する第1冷却処理装置群70 の多段ユニット部に属するエクステンション装置了4や 第1加熱処理装置群90に属するアライメント装置92 に対してアクセスできるように構成されている。

【①①16】処理ステーション3では、正面側にレジス ト盤布装置群20が、背面側に現像処理装置群30がそ れぞれ配置されている。正面側に現像処理装置群30 を、背面側にレジスト塗布装置群20をそれぞれ配置し ても勿論機わない。

【0017】レジスト塗布装置群20は図2及び図3に 示すように、カップCP内でウェハWをスピンチャック 50 配置されており、第2冷却処理装置群80及び第2加熱

に載せてレジスト液を塗布して、該ウェハ♥に対してレ ジスト塗布処理を施サレジスト塗布装置21、22が並 列配置され、さらにこれらるレジスト盤布装置21、2 2の上段にはレジスト塗布装置23.24が積み重ねち れて構成されている。

【0018】現像処理装置群30は、カップCP内でウ ェハ双をスピンチャックに載せて現像液を供給して、該 ウェハWに対して現像処理を施す現像処理装置31、3 2が並列配置され、さらにこれら各現像処理装置31、 32の上段には現像処理装置33、34が積み重ねられ て構成されている。

【0019】処理ステーション3の中心部には、ウェハ Wを載置自在な受け渡し台40が備えられている。

【0020】との受け渡し台40を挟んで上記レジスト 塗布装置群20と現像処理装置群30とは相対向してお り、レジスト盤布装置群20と受け渡し台40との間に は第1截送装置50が、現像処理装置群30と受け渡し 台40との間には第2鍛送装置60がそれぞれ装備され

【0021】第1銀送装置50と第2級送装置60とは 基本的に同一の構成を有しており、第1銀送装置50の 機成を図4に基づいて説明すると、第1銀送装置50 は、上端及び下端で相互に接続され対向する一体の壁部 51.52からなる筒状支持体53の内側に、上下方向 (2方向)に昇降自在なウェハ鍛送手段54を備えてい る。筒状支持体53はモータ55の回転軸に接続されて おり、このモータ55の回転駆動力で、前記回転軸を中 心としてウェハ扱送手段54と共に一体に回転する。従 って、ウェハ搬送手段54は8方向に回転自在となって いる。

【0022】ウェハ鍛送手段54の搬送基台56上に は、ウェハWを保持する保持部材としての複数、例えば 2本のピンセット57、58が上下に備えられている。 各ピンセット57、58は基本的に同一の構成を有して おり、筒状支持体53の両壁部51、52間の側面関口 部を通過自在な形態及び大きさを有している。また、各 ピンセット57.58は搬送基台56に内蔵されたモー タ (図示せず) により前後方向の移動が自在となってい る。なね、第2搬送装置60には、ピンセット57、5 8と同一の機能及び構成を有するピンセット67.68 が備えられている。

【0023】第1鍛送装置50の両側には、レジスト塗 布装置群2()近傍に各種冷却系処理装置からなる第1冷 却処理装置群での及び第2冷却処理装置群80がそれぞ れ配置されており、第2級送裝置60の両側には、現像 処理装置群30の近傍に各種加熱系処理装置からなる第 1加熱処理装置群90及び第2加熱処理装置群100が それぞれ配置されている。第1冷却処理装置群70及び 第1 加熱処理装置群90はカセットステーション2側に 処理装置群 1 () () はインターフェイス部 5 側に配置されている

【()()24】ととで処理ステーション3をカセットステ ーション2側から見た図2に基づいて、第1冷却処理装 置群70及び第1加熱処理装置群90の構成を説明する と、第1冷却処理装置群70は、ウェハWを所定温度で 冷却処理するケーリング装置71、72と、ウェハWの 位置合わせを行うアライメント装置で3と、ウェハWを 待機させるエクステンション装置74と、冷却処理装置 75.76、77、78とが下から順に、例えば8段に 10 **請み重ねられている。第1加熱処理装置群90は、レジ** ストとウェハ♥との密着性を向上させるアドヒージョン 装置91と、アライメント装置92と、エクステンショ ン装置93と、レジスト堂布後のウェハWを加熱処理す るプリペーキング装置94.95と、現像処理後のウェ ハWを加熱処理するポストベーキング装置96、97、 98とが下から順に、例えば8段に積み重ねられてい る.

【①025】処理ステーション3をインターフェイス部5側から見た図3に基づいて第2冷却処理装置群80及20 び第2加熱処理装置群100の構成を説明すると、第2冷却処理装置群80は、クーリング装置81、82と、アライメント装置83と、エクステンション装置84と、冷却処理装置85、86、87、88とが下から順に、例えば8段に積み重ねられている。第2加熱処理装置群100は、ブリベーキング装置101、102と、露光処理後のウェハΨを加熱処理するボストエクスポージャベーキング装置103、104と、ボストベーキング装置105、106、107とが下から順に、例えば7段に積み重ねられている。30

【0026】インターフェイス部5には、銀送装置11 のが処理ステーション3における第2冷却処理装置群8 のと対面するように配置されている。図5はこのインターフェイス部5を側面から見た図であり、インターフェイス部5では、この銀送装置110を挟むように、その一方には熱処理装置111を多段に配置してなる熱処理 装置群112が配置され、他方には周辺露光装置11 3. バッファカセット114及びウェハ保持部115が 上から順番に積層配置されている。

【0027】 掘送装置110は、図4に示した第1銀送 40 装置50 (第2 掘送装置60)と基本的に同一の構成を有しており、従ってウェハΨを垂直方向(2方向)に移動可能であり、更にθ方向に回転可能に構成され、その周囲に配置された処理ステーション3における第2冷却処理装置群80のアライメント装置83及びエクステンション装置84、各熱処理装置111、周辺露光装置113、ウェハΨを垂直方向に例えば25枚収容するバッファカセット114並びにウェハ保持部115との間でウェハΨの受け渡しが可能となっている。

【0028】図6は上述した熱処理装置111の平面

図. 図7はその断面図である。

【0029】これらの図に示すように、熱処理装置111は、熱板343を有する加熱処理室341と、これに 解接して設けられた基板を温調する温調部としての冷却 処理室342とを有している。この熱処理装置111 は、さらに鍛送装置110との間でウェハWを受け渡し する際に関閉される第1のグートシャッター344と、 加熱処理室341と冷却処理室342との間を開閉する ための第2のゲートシャッター345と、熱板343の 園田でウェハWを包囲しながら第2のゲートシャッター 345と共に昇降されるリングシャッター346と、後 述する2次銀送体116との間でウェハWを受け渡しする 際に開閉される第3のゲートシャッター361を有している。さらに、熱板343には、ウェハWを載置して 昇降するための3個のリフトピン347が昇降自在に設 けられている。

【0030】加熱処理室341の下方には、上記3個のリフトピン347を昇降するための昇降機構348と、リングシャッター346を第2のゲートシャッター345と共に昇降するための昇降機構349と、第1のゲートシャッター361を昇降して関閉するための昇降機構350とが設けられている。また、この加熱処理室341は排気管351を介して排気されるように構成されている。

【0031】加熱処理室341と冷却処理室342とは、追運口352を介して追運されており、ウェハWを 報置して冷却するための冷却板353がガイドプレート 354に沿って移動機構355により水平方向に移動自 在に構成されている。これにより、冷却板353は、連 連口352を介して加熱処理室341内に進入することができ、加熱処理室341内の熱板343により加熱された後のウェハWをリフトビン347から受け取って冷却処理室342内に強入し、ウェハWの冷却後、ウェハ Wをリフトビン347に戻すようになっている。

【0032】図8は上述したウェハ保持部115の構成を示す断面図である。

【①①33】図8に示すように、このウェハ保持部115では、ウェハWを常温付近の温度となるように温調する温調台としての冷却装置321が下段に配置されている。冷却装置321は、当該冷却装置321に載置したウェハWを冷却自在な冷却載置台325と、冷却或置台325に設けられた孔326からシリンダ327の駆動により上下動自在に形成された例えば3本の昇降ビン328とが備えられている。そして、冷却載置台325の内部には、例えば23℃に温度調整された恒温水等が流通する循環路329が設けられている。これによって、冷却載置台325上に戴置されたウェハWが冷却されるようになっている。また、最上段の冷却装置321の上部には、ウェハWを載置自在な載置台330、330が上下2段備えられている。なお、冷却装置321には露

特闘2001-77014

光前のウェハWが一旦保持され、咸園台330、330 には露光後でかつ加熱・冷却処理終了後のウェハ型が一 旦保持されるようになっている。

【0034】図1に示したように、熱処理装置群112 及びウェハ保持部115と露光装置4との間には垂直方 向(Z方向)及びX方向に移動可能であり更に8方向に 回転可能な2次級送体116が鍛送路117に沿って移 動自在であり、熱処理装置群112の各熱処理装置11 1. ウェハ保持部115の冷却装置321、露光装置4 における露光前のウェハWが載置されるインステージ4 0 1及び鉱光後のウェハWが載置されるアウトステージ 402との間でウェハWの扱入出を行うようになってい

【① () 3.5 】本発明の実施の形態にかかる塗布現像処理 システム1は以上のように構成されている。次に、塗布 現像処理システム1の動作について説明する。

【①①36】まずカセットステーション2においてウェ ハ搬送体!!がカセットCにアクセスして未処理のウェ ハWを1枚取り出す。次いで、このウェハWはウェハ鍛 送体11により第1加熱処理装置群90のアライメント 20 装置92に鍛送される。アライメント装置92で位置台 わせを終了したウェハ型は、第2鍛送装置60により同 じ第1加熱処理装置群90に属するアドヒージョン装置 91に銀送される。次いで、この韓水化処理終了後、ウ ェハWは第2扱送装置60により受け渡し台40に鍛送 される。

【0037】次いで、ウェハ♥は第1搬送装置50によ り受け渡し台40から第1冷却処理装置群70に搬送さ れ、第1冷却処理装置群で()の例えばクーリング装置で 2に扱入され、冷却処理が行われる。

【0038】とのクーリング装置72で所定の冷却処理 が終了したウェハWは、第1敏送装置50によりレジス ト盤布装置群2()に鍛送される。

【①①39】レジスト塗布装置群20に鍛送されたウェ ハWは、例えばレジスト整布装置21に鍛入され。レジ スト膜が形成される。そして、レジスト膜が形成された ウェハWは、その後第1扱送装置50により受け渡し台 40に做送される。

【0040】受け渡し台40に鍛送されたウェハ型は、 第2 搬送装置60により今度は第2加熱処理装置群10 0に搬送される。そして、第2加熱処理装置群100に 属する、例えばプリベーキング装置101に鍛入されて 所定の加熱処理が施される。

【0041】かかる加熱処理終了後のウェハWは第2鎖 送装置60により第2冷却処理装置群80に搬送され る。そして、第2冷却処理装置群80の例えばケーリン グ装置85に扱入されて、冷却処理が能される。クーリ ング装置85で冷却処理が終了したウェハ型は、その後 エクステンション装置84に鍛入される。

【①042】エクステンション装置84に搬入されたウ 50 像処理後の加熱処理が施される。

ェハWは、鍛送装置110によりインターフェイス部5 内に搬入され、まずインターフェイス部5における周辺 露光装置113に嵌入され、周辺露光処理が施される。 【0043】周辺露光処理が施されたウェハ型は、敏送 装置110によりバッファカセット114に一旦収容さ

【①①44】バッファカセット114に収容されている ウェハWは、搬送装置110によりウェハ保持部115 における冷却装置321に搬送それ。常温付近の温度例 えば23℃程度に温調される。これにより、その後この ウェハWが露光装置4内に搬送されたときに露光装置4 内の温度を乱すようなことはなくなる。

【0045】ウェハ保持部115における冷却装置32 1で常温付近に温調されたウェハWは、2次銀送体11 6により露光装置4におけるインステージ401上に戴 置される。

【0046】インステージ401上に載置されたウェハ Wは、基光装置4内で基光処理が行われ、基光処理が終 了するとアウトステージ402上に戦置される。

【0047】アウトステージ402上に就置されたウェ ハ♥は、2次搬送体116により直接的に熱処理装置群 112におけるいずれかの熱処理装置111に搬送され る。ここで、副御部362は、露光装置4からウエハW の翠光が終了したタイミングを示す翠光終了信号を入力 し、この信号に基づき、ウエハマが離光終了から熱処理 装置111に搬送されるまでの時間が常に一定となるよ うに2次銀送体116による銀送動作を制御している。 例えば、2次級送体116がウェハ原持部115におけ る冷却装置321から露光装置4におけるインステージ 4.01上にウエハを鍛送するタイミングであっても、制 御部362は、その動作を中断させ(割り込みをかけ て) ウェハWが露光終了から熱処理装置 1 1 1 に銀送 されるまでの時間が常に一定となるように、2次搬送体 116に対してアウトステージ402から熱処理装置群

112にウエハ♥を鍛送させるように制御している。 【0048】熱処理装置111に鍛送されたウエハW は、熱処理及び常温への温調が行われる。

【①①49】熱処理及び常温への温調が行われたウェハ ♥は、鍛送装置110により処理ステーション3におけ るエクステンション装置84に嵌入される。

【0050】エクステンション装置84に鍛入されたウ ェハWは、第1搬送装置50により受け渡し台40に撤 送される。その後、ウェハWは第2級送装置60により 受け渡し台40から現像処理装置群30における。例え は現像処理装置31に嵌入されて所定の現像処理が施さ

【0051】かかる現像処理が終了したウェハ型は、第 2搬送装置60により第2加熱処理装置群100におけ る。例えばポストペーキング装置105に鍛入されて現

http://www4.ipdl.inpit.go.jp/tjcontentdben.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N040... 11/19/2007

【①052】ポストペーキング装置105における加熱 処理が終了したウェハWは、第2銀送装置60により受 け渡し台40に搬送される。

【0053】受け渡し台40に鍛送されたウェハ製は、 その後第1撤送装置50により第1冷却処理装置群70 における、例えばクーリング装置71に銀入されて冷却 処理される。

【0054】そして、冷却処理されたウェハ型は、その 後エクステンション装置74に鍛入されてその場で待機 する。そして、エクステンション装置74からウェハ鍛 10 送体 1 1 で鍛出され、カセット執置台 1 0 上のカセット Cに収納される。こうして、ウェハ♥に対する一連の塗 布現像処理が終了する。

【① 055】とのように本実施形態の盤布現像処理シス テム」においては、露光後のウェハ♥を待たせることな く直ぐに熱処理装置111へ鍛送して加熱処理を行わせ ることができる。従って、露光後のウェハ♥を匍熱処理 するまでの時間を正確に管理することができ、均一な線 幅を形成することができる。

11には加熱処理室341の他に冷却処理室342が一 体的に設けられているので、加熱処理が終了したウェハ Wを直ぐに温調することができ、従って温度管理を正確 に行うことができ、これによっても均一な線幅を形成す るととが可能となる。

【0057】更に、本裏餡形態では、特にインターフェ イス部5における鍛送装置110の周りに処理ステーシ ョン3、ウェハ保持部115及び熱処理装置111を配 置するようにしたので、接送装置110はXY方向へ移 動することが不要となり、搬送装置110の高速化を図 30 ることができる。

【()()58】次に、本発明の他の実施形態を説明する。

【① 059】図9は本発明の他の実施形態に係る盤布現 像処理システム370の構成を示す平面図である。

【0080】図9に示す塗布現像処理システム370で は、2次銀送体116との間でウェハ型の銀出が可能 で、露光前のウェハWを受け入れ一旦保持する第1の保 持部としての冷却装置371と2次接送体116との間 でウェハWの搬入が可能で、篝光後のウェハWを受け入 れ一旦保持する第2の保持部としての載置台372とが 40 同一の平面上に配置されている。鍛送装置110は冷却 接置371、熱処理装置111及び載置台372との間 でウェハΨの受け渡しが可能に構成されている。

【① 061】本実施形態に係る塗布現像処理システム3 70では、特に冷却装置371と報置台372とが同一 の平面上に配置されているので、2次接送部116にお いてウェハWを垂直方向に搬送するストロークが小さく なり、2次鍛送部116の小型化及び高速化を図ること ができる。

2を介してアウトステージ402から熱処理装置111 に接送するような構成としたので、截置台372がいわ はタイミングバッファとしての役割を果し、制御部36 3が2次銀送体116及び搬送装置110の鍛送タイミ ングを適宜制御することによってウエハWがアウトステ ージ402から熱処理装置111へ搬送される時間を一 定にすることが簡単にできるようになる。

【①063】次に、本発明の更に別の実施形態を説明す

【①①64】図10はこの実施形態に係る塗布現像処理 システム380の構成を示す平面図である。

【0065】とのシステムでは、鍛送装置110が、処 **運ステーション 3、熱処温装置群 1 1 2 及びウェハ保持** 部115はかりでなく、インステージ401及びアウト ステージ4()2に対しても直接的にアクセスできるよう にしたものである。そして、処理ステーション3側から 做入された露光前のウエハWは做送装置110. ウェハ 保持部115及び鍛送装置110を経てインステージ4 () 1に受け渡され、アウトステージ4()2から搬出され 【0056】また、本実施形態では、特に熱処理装置1 20 た露光後のウエハWは搬送装置110を経て熱処理装置 群112に鍛送され、その後、鍛送装置110を経て処 **翅ステーション3側へ鍛出される。本実施形態において** も最初に示した実施形態と同様に、躍光後のウエハ♥を 鍛送装置110を経て熱処理装置群112に鍛送する制 御を優先的に行い、露光終了から熱処理装置への芸板の 鎖入までの時間を一定とするように制御しても良い。

> 【0066】なお、上記実能の形態ではウェハ♡を基板 として使用した例を挙げて説明したが、本発明に使用さ れる墓板はこれに限らず、例えばLCD基板等であって しょいん

[0067]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 露光後の基板を待たせることなく直ぐに熱処理部へ鍛送 して加熱処理を行わせることができるので、露光後の基 板を加熱処理するまでの時間を正確に管理することがで き、均一な根帽を形成することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一裏施形態に係る壁布現像処理システ ムの平面図である。

【図2】図1に示した塗布現像処理ンステムにおける処 **翅ステーションの左側面図である。**

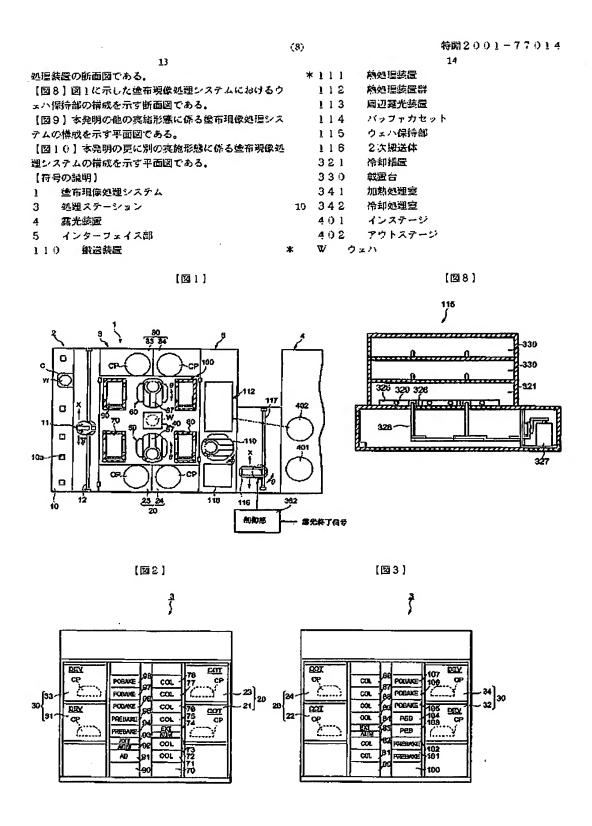
【図3】図1に示した塗布現像処理システムにおける処 選ステーションの右側面図である。

【図4】図1に示した塗布現像処理システムにおける第 1 搬送装置の構成を示す斜視図である。

【図5】図1に示した塗布現像処理システムにおけるイ ンターフェイス部を右側図である。

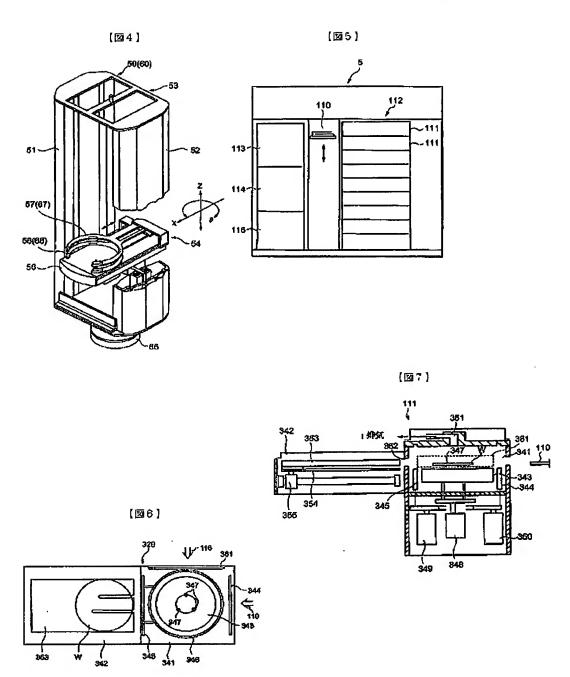
【図6】図1に示した塗布現像処理システムにおける熱 処理装置の平面図である。

【①①62】また、本実能形態では、特に、戴置台37~50 【図7】図1に示した塗布現像処理システムにおける熱

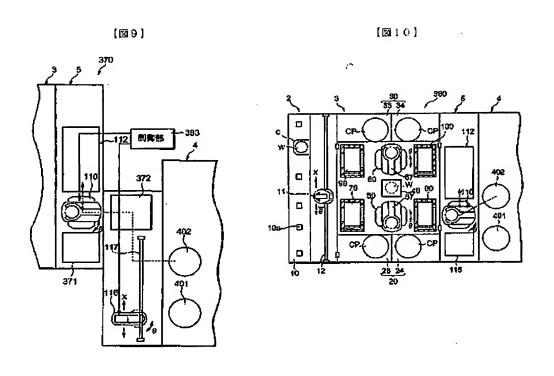


待闘2001-77014





(10) 特闘2001-77014



フロントページの続き

(51) Int.Cl.

族別記号

F! H01L 21/30

567

テーマコード(容秀)

http://www4.ipdl.inpit.go.jp/tjcontentdben.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N040... 11/19/2007